

性能特点：

- 通带频段：8.0~12.0GHz
- 通带损耗：0.7 dB/1 dB/1 dB
- 均衡量：2dB/3dB/4dB
- 回波损耗：20dB
- 芯片尺寸：0.8mmx0.85mm x 0.1mm

产品简介：

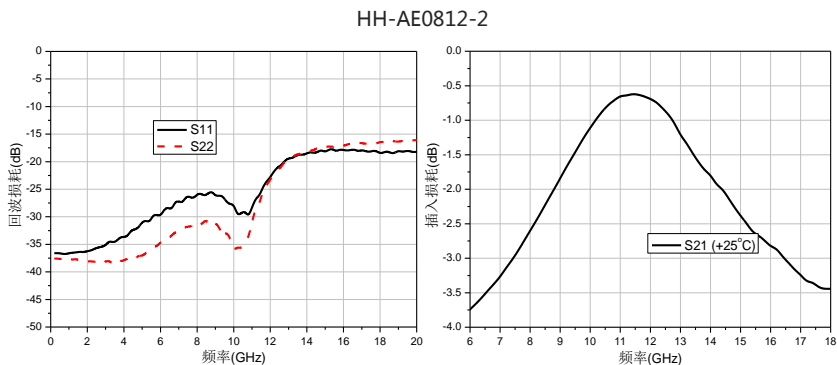
HH-AE0812是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点，广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。芯片尺寸0.8mmx0.85mm x 0.1mm。

电参数： ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

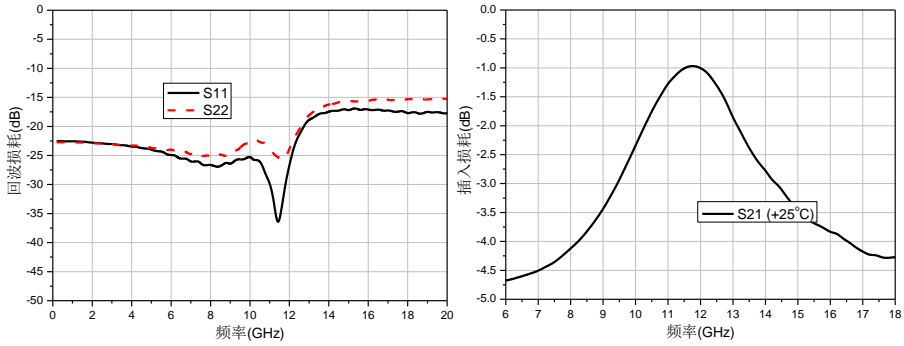
指标		最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		8~12			GHz
插入损耗	HH-AE0812-2	0.7	-	2.6	dB
	HH-AE0812-3	1	-	4.2	dB
	HH-AE0812-4	1	-	5.0	dB
均衡量	HH-AE0812-2	-	2	-	dB
	HH-AE0812-3	-	3	-	dB
	HH-AE0812-4	-	4	-	dB
输入回波损耗		20	-	-	dB
输出回波损耗		20	-	-	dB

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

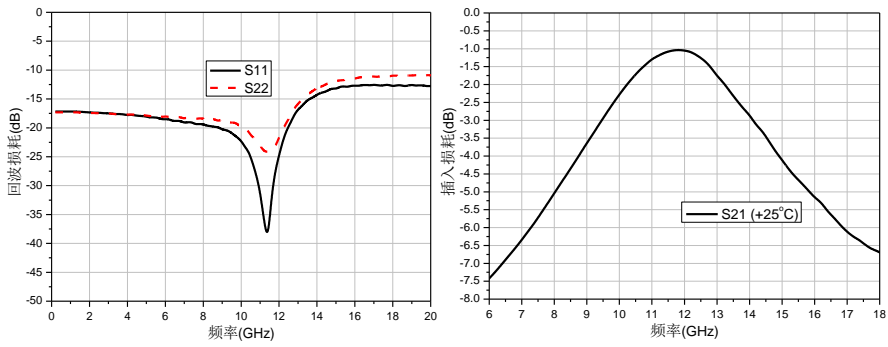
最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

典型曲线： ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)


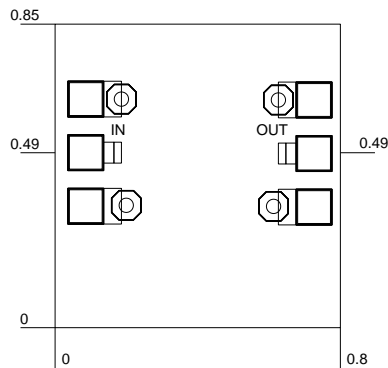
HH-AE0812-3



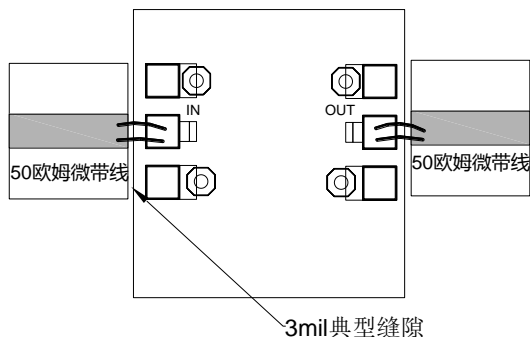
HH-AE0812-4



尺寸图: (单位mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。